

1. 概述和特点

ESD8D7.0C 是利用先进的硅电路工艺生产的双向低电容静电放电保护器件，主要用于电路元件快速过电保护，封装形式为 DFN1006-2L

- 快速的响应时间
- 低箝位电压
- 低漏电电流 (<100nA)
- 低电容
- 适合于高速数据传输线的 ESD 保护：
IEC61000-4-2 (ESD)，±30kV（空气放电）；±30kV（接触放电）
- 并联使用
- 封装外型：DFN1006-2L

典型参数

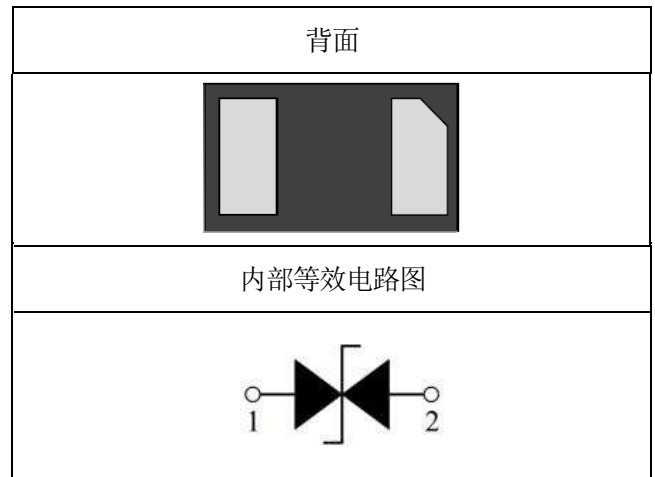
$$P_{PK}=72W$$

$$V_{RWM}=7V$$

$$V_{C@I_{PP}=6.0A}=12V$$

$$I_{PP}=6.0A$$

$$C_j=15pF$$



2. 电特性

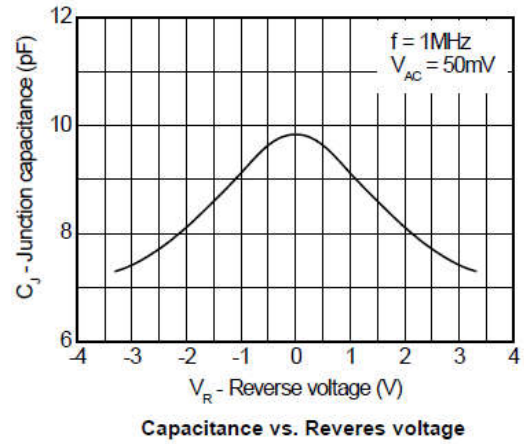
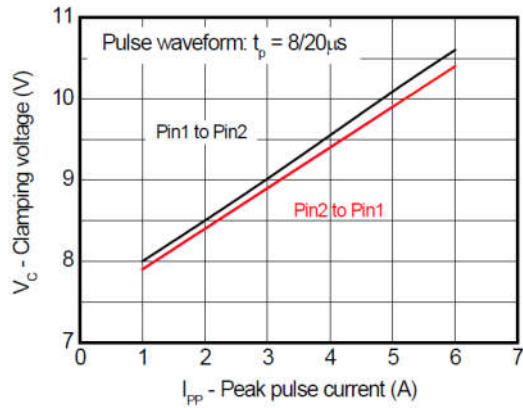
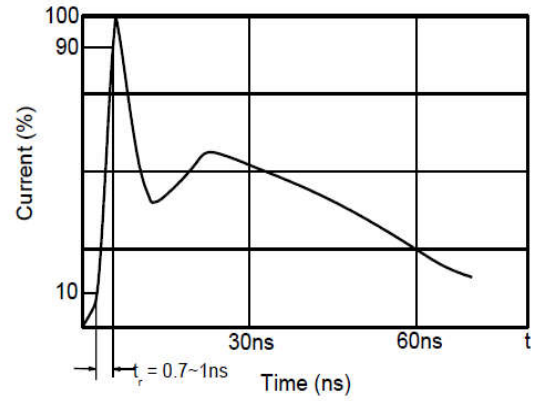
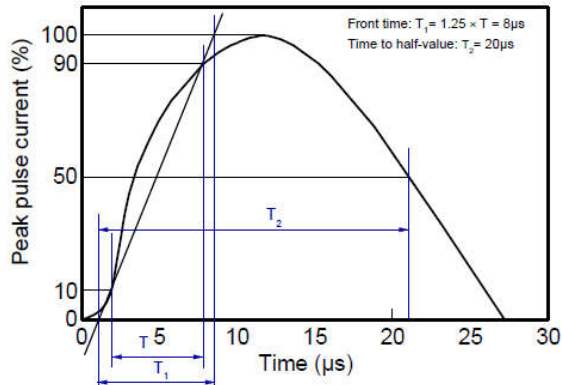
2.1 极限参数 (T_a= 25℃)

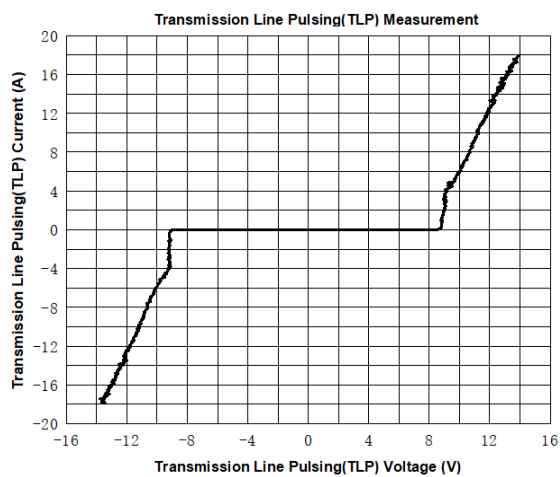
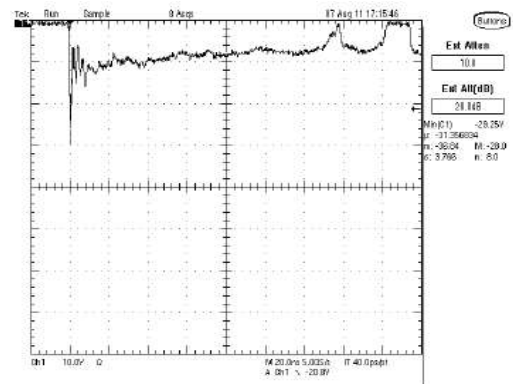
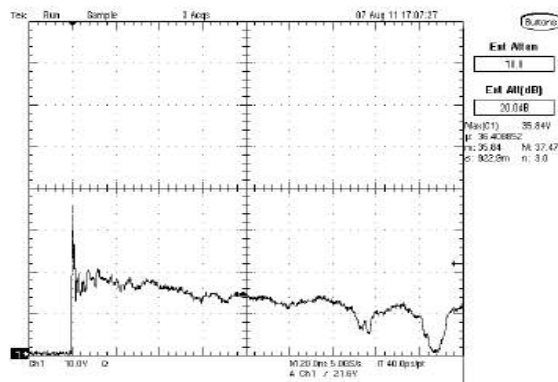
参数	Symbol	Rating	Unit
最大峰值功率(8/20us)	P _{PK}	72	W
最大峰值脉冲电流 (8/20us)	I _{PP}	6.0	A
最高工作温度范围	T _{OP}	-55 ~ +150	°C
最高存储温度范围	T _{STG}	-55 ~ +150	°C

2.2 常规参数 (T_a= 25℃)

参数	Symbol	Test Conditions	Criterion			Unit
			Min	Typ	Max	
维持电压	V _{RWM}				7	V
击穿电压	V _{BR}	I _t =1mA	7.6		9.0	V
漏电流	I _R	V _{RWM} =±7.0V			0.1	uA
钳位电压	V _C	I _{pp} =1A, tp=8/20us		9	12	V
钳位电压	V _C	I _{pp} =6.0A, tp=8/20us		12	16	V
电容	C _j	V _R =0V, f=1Mz		15		pF

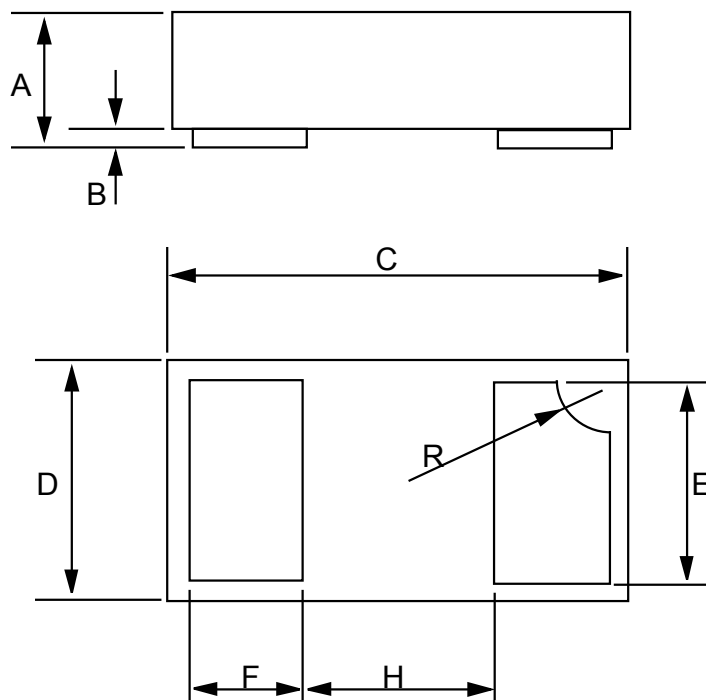
3. 特征曲线





Package Outline

DFN1006-2L



Dim	Inches		Millimeters	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.013	0.015	0.34	0.40
B	0.000	0.002	0.00	0.05
C	0.037	0.042	0.95	1.075
D	0.021	0.026	0.55	0.675
E	0.017	0.021	0.45	0.55
F	0.007	0.011	0.20	0.30
H	0.015Typ.		0.40Typ.	
R	0.001	0.005	0.05	0.15

Summary of Packing Options

Package	Package Description	Packing Quantity	Industry Standard
DFN1006-2L	Tape/Reel, 7" reel	10000	EIA-481-1